

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 S1XV2100Q100L 肖特基二极管	文件编号	XS-V-002
		版本号	19-A1-04
		页码	1/2

1 主要用途及主要特点

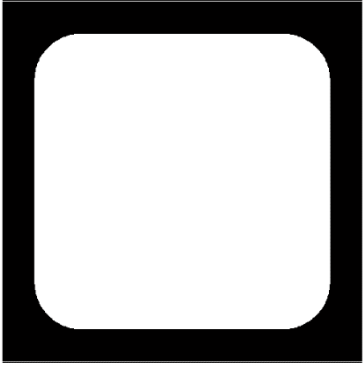
1.1 主要用途

用 S1XV2100Q100L 封装的成品管用于开关电源、高频逆变器、极性保护电路等各类电子电路上。

1.2 主要特点

- 高 ESD 能力
- 低正向
- 高抗浪涌电流能力

2 芯片数据

	芯片示意图	芯片尺寸	2.1mm×2.1mm 82.7mil × 82.7mil
	芯片厚度 (μm)	260±20	
	划片道尺寸 (μm)	60	
	键合区面积 (μm ²)	正面	1600×1600
	正面电极 (阳极)	金属	铝
		厚度 (μm)	4±0.4
	背面电极 (阴极)	表层金属	银
	硅片直径 (mm)	φ 150	
	理论管芯数 (颗)	3600	
	装片要求 (推荐)	焊料	
键合要求 (推荐)	铝丝: φ 380 μ m*2 根		

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	100	V	推荐封装形式: T0-220 推荐成品型号: MBR20100CT
正向电流	$I_{F(AV)}$	10	A	
正向峰值浪涌电流@8.3ms	I_{FSM}	180	A	
结温	T_j	150	°C	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	°C	

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
 电话: (0510) 86851182 86852109

网址: <http://www.xs-elec.com/>
 传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 S1XV2100Q100L	文件编号	XS-V-002
	肖特基二极管	版本号	19-A1-04
		页码	2/2

3.2 电参数

除非另有规定， $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R=200\mu\text{A}$	100	113	-	V
反向电流	I_R	$V_R=100\text{V}$	-	15	50	μA
正向电压	V_F	$I_F=1\text{A}$	-	0.38	-	V
正向电压	V_F	$I_F=3\text{A}$	-	0.45	-	V
正向电压	V_F	$I_F=5\text{A}$	-	0.51	-	V
正向电压	V_F	$I_F=10\text{A}$	-	0.63	0.70	V

注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；

任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号
 电话：(0510) 86851182 86852109

网址：<http://www.xs-elec.com/>
 传真：(0510) 86851532